

1. Спосіб отримання легованих кристалів PbTe:Bi n- і р-типу провідності, який полягає в тому, що вихідну речовину із окремих компонентів, розташовану в кварцовій вакуумованій ампулі, поміщають у двозонну піч, температура першої зони якої є вищою від температури плавлення вихідної речовини, а температура другої зони є нижчою від температури плавлення вихідної речовини, ампулу з вихідною речовиною витримують у першій зоні і переміщують у другу зону до здійснення кристалізації, після чого охолоджують до кімнатної температури, який **відрізняється** тим, що як вихідну речовину використовують чистий свинець і телур, взяті у співвідношенні, що відповідає складу сполуки PbTe, і вісмут.

2. Спосіб отримання легованих кристалів PbTe:Bi n- і р-типу провідності за п. 1, який **відрізняється** тим, що для отримання кристалів PbTe:Bi р-типу концентрація вісмуту складає $N_{Bi} \leq 0,2$ ат. %, а n-типу відповідно $N_{Bi} > 0,2$ ат. %.